

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

	Min.	Typ.	Max.
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ¹⁾ $I_C = 10\text{ mA}, I_B = 1\text{ mA}$ V_{BEsat}	–	–	1 V
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾ $V_{CE} = 20\text{ V}, I_C = 25\text{ mA}$ h_{FE}	50	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz $V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$ f_T	–	100 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität $V_{CB} = 30\text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1\text{ MHz}$ C_{CB0}	–	0.8 pF	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thA}		420 K/W ²⁾
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren	BFN 23		
Marking - Stempelung	BFN 22 = HB		

¹⁾ Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

²⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß